

1. 一种半导体结构，其中，包括：
半导体衬底；
位于所述半导体衬底上方的层间介质层以及位于所述层间介质层内的至少两层金属互连层；
激光熔丝，位于底层金属互连层上方的任一金属互连层内；
金属岛，位于所述激光熔丝下层的各金属互连层内，不同金属互连层内的金属岛之间通过导电接触孔连接，形成两条导电通路，所述激光熔丝通过导电接触孔串联所述两条导电通路；
对准标记，与所述激光熔丝位于同一金属互连层内，作为对所述激光熔丝进行熔断时的激光对准的标记。
2. 根据权利要求 1 所述的半导体结构，其中，自半导体衬底向上至所述激光熔丝方向上，每一导电通路内，所述导电接触孔及所述金属岛沿平行于所述半导体衬底表面方向上的横截面的关键尺寸逐层增大。
3. 根据权利要求 1 所述的半导体结构，其中，任一层导电接触孔/金属岛在半导体衬底上的投影位于上层的导电接触孔/金属岛在半导体衬底上的投影内。
4. 根据权利要求 1 所述的半导体结构，其中，所述层间介质层内具有与所述金属岛的顶部表面齐平的第一阻挡层。
5. 根据权利要求 4 所述的半导体结构，其中，所述层间介质层内还具有位于所述第一阻挡层表面环绕导电接触孔底部的第二阻挡层。
6. 根据权利要求 1 所述的半导体结构，其中，所述激光熔丝和所述对准标记表面覆盖有保护层。
7. 根据权利要求 6 所述的半导体结构，其中，还包括：覆盖所述层间介质层的顶部介质层，所述顶部介质层内形成有位于所述激光熔丝与所述对准标记上方的熔断窗口，所述熔断窗口底部与所述激光熔丝、所述对准标记表面之间具有部分厚度的介质材料，作为所述激光熔丝和所述对准标记表面的所述保护层。

8. 根据权利要求 6 所述的半导体结构，其中，所述保护层包括氧化硅层、氮化硅层或氮氧化硅层中的至少一层。
9. 根据权利要求 6 所述的半导体结构，其中，所述保护层的厚度为 20nm~200nm。
10. 根据权利要求 1 所述的半导体结构，其中，所述激光熔丝与单个金属岛之间通过一个或两个以上的导电接触孔连接。
11. 一种半导体结构的形成方法，其中，包括：
提供半导体衬底；
在所述半导体衬底上方形成层间介质层以及位于所述层间介质层内的至少两层金属互连层，包括：
在底层金属互连层上方的任一金属互连层内形成激光熔丝，以及位于所述激光熔丝下层的各金属互连层内的金属岛，不同金属互连层内的金属岛之间通过导电接触孔连接，形成两条导电通路，所述激光熔丝通过导电接触孔串联所述两条导电通路；
还包括形成与所述激光熔丝位于同一金属互连层内的对准标记，所述对准标记作为对所述激光熔丝进行熔断时的激光对准的标记。
12. 根据权利要求 11 所述的半导体结构的形成方法，其中，自半导体衬底向上至所述激光熔丝方向上，每一导电通路内，所述导电接触孔及所述金属岛沿平行于所述半导体衬底表面方向上的横截面的关键尺寸逐层增大。
13. 根据权利要求 12 所述的半导体结构的形成方法，其中，任一层导电接触孔/金属岛在半导体衬底上的投影位于上层的导电接触孔/金属岛在半导体衬底上的投影内。
14. 根据权利要求 11 所述的半导体结构的形成方法，其中，所述层间介质层内具有与所述金属岛的顶部表面齐平的第一阻挡层，作为形成位于上层的导电接触孔的通孔的刻蚀停止层；所述层间介质层内还具有位于所述第一阻挡层表面环绕导电接触孔底部设置的第二阻挡层。
15. 根据权利要求 11 所述的半导体结构的形成方法，其中，还包括：形成覆盖所述层间介质层的顶部介质层；刻蚀所述顶部介质层，形成位于所述激光

熔丝与所述对准标记上方的熔断窗口，所述熔断窗口底部与所述激光熔丝、所述对准标记表面之间具有部分厚度的介质材料，作为覆盖所述激光熔丝和所述对准标记表面的所述保护层。

16. 根据权利要求 11 所述的半导体结构的形成方法，其中，在所述激光熔丝与单个金属岛之间形成一个或两个以上的导电接触孔。

17. 一种半导体结构内的激光熔丝的熔断方法，所述半导体结构如权利要求 1 所述，其中，包括：

利用所述对准标记将激光对准至熔断位置，采用激光对所述激光熔丝进行熔断，以使所述两个导电通路之间断路，其中，所述熔断过程中，将激光熔丝及下方的导电通路内的金属岛及导电接触孔均进行激光熔断。